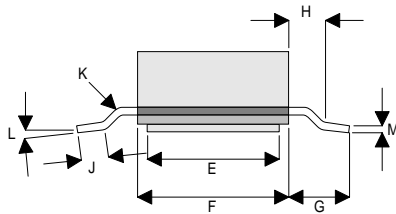
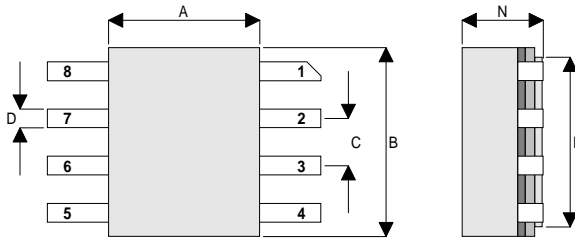


MECHANICAL DATA



SO8 PACKAGE

- PIN 1 – SOURCE
- PIN 2 – DRAIN
- PIN 3 – DRAIN
- PIN 4 – SOURCE
- PIN 5 – SOURCE
- PIN 6 – GATE
- PIN 7 – GATE
- PIN 8 – SOURCE

Dim.	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	4.06	±0.08	0.160	±0.003
B	5.08	±0.08	0.200	±0.003
C	1.27	±0.08	0.050	±0.003
D	0.51	±0.08	0.020	±0.003
E	3.56	±0.08	0.140	±0.003
F	4.06	±0.08	0.160	±0.003
G	1.65	±0.08	0.065	±0.003
H	0.76	+0.25 -0.00	0.030	+0.010 -0.000
J	0.51	Min.	0.020	Min.
	1.02	Max.	0.040	Max.
K	45°	Max.	45°	Max.
L	0°	Min.	0°	Min.
	7°	Max.	7°	Max.
M	0.20	±0.08	0.008	±0.003
N	2.18	Max.	0.086	Max.
P	4.57	±0.08	0.180	±0.003

**GOLD METALLISED
MULTI-PURPOSE SILICON
DMOS RF FET
5W – 12.5V – 1GHz
SINGLE ENDED**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- VERY LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 2 GHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	17.5W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage	40V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current	4A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
BV_{DSS} Drain–Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0$ $I_D = 10\text{mA}$	40			V
I_{DSS} Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 12.5\text{V}$ $V_{GS} = 0$			2	mA
I_{GSS} Gate Leakage Current	$V_{GS} = 20\text{V}$ $V_{DS} = 0$			1	μA
$V_{GS(th)}$ Gate Threshold Voltage*	$I_D = 10\text{mA}$ $V_{DS} = V_{GS}$	0.5		7	V
g_{fs} Forward Transconductance*	$V_{DS} = 10\text{V}$ $I_D = 0.4\text{A}$	0.36			S
G_{PS} Common Source Power Gain	$P_O = 5\text{W}$	10			dB
η Drain Efficiency	$V_{DS} = 12.5\text{V}$ $I_{DQ} = 0.2\text{A}$	40			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	$f = 1\text{GHz}$	20:1			—
C_{iss} Input Capacitance	$V_{DS} = 0\text{V}$ $V_{GS} = -5\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$			24	pF
C_{oss} Output Capacitance	$V_{DS} = 12.5\text{V}$ $V_{GS} = 0$ $f = 1\text{MHz}$			20	pF
C_{rss} Reverse Transfer Capacitance	$V_{DS} = 12.5\text{V}$ $V_{GS} = 0$ $f = 1\text{MHz}$			2	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2\%$

THERMAL DATA

$R_{THj-case}$	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 6°C / W
----------------	------------------------------------	--------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D2220UK](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9